105年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員 考試及105年特種考試交通事業鐵路人員考試試題

代號:3909 頁次:7-1

考 試 別:鐵路人員考試

等 别:佐級考試 類 科 別:電子工程 目:電子學大意 科

考試時間:1小時

座號:

※注意:(一)本試題為單一選擇題,請選出一個正確或最適當的答案,複選作答者,該題不予計分。

- 二共40 題,每題2.5 分,須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記,於本試題上作答者,不予計分。
- (三)可以使用電子計算器。
- 某一內部補償的運算放大器,其直流開迴路增益為 100 dB,單一增益頻寬(Unity-gain Bandwidth) 為2MHz,求頻率在2kHz時的開迴路增益?

(B)20 dB

(C)30 dB

(D)60 dB

2 一運算放大器其增益為3×10⁵,直流供應電壓為±12 V,最大輸出電壓變化範圍為±11.5 V,當其正輸 入端與負輸入端電壓分別為 50 μV 和 90 μV, 其輸出電壓為何?

(B)-11.5 V

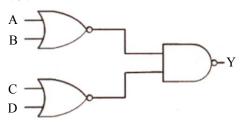
某單一增益運算放大器的電壓轉換率(Slew rate)為 0.628 V/μs,當輸入電壓振幅為 5 V 之正弦波時, 其最大不失真的輸入頻率為何?

(A) 1 kHz

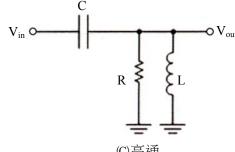
(C) 10 kHz

(D)20 kHz

圖中邏輯電路的輸出信號 Y 為何?



- (A) Y = A + B + C + D
- (B) Y = ABCD
- (C) Y = (A + B)(C + D)
- (D) Y = (A + B)(C + D)
- 若雙極性接面電晶體 (BJT) 工作在主動區 (Active Region) 的電流放大率為 β, 下列何項敘述正確? (A)β 定義為 I_B/I_C
 - (B)相同電路之下,β較小的電晶體較易飽和
 - (C)β 值大小與溫度無關
 - (D)工作在飽和區(Saturation Region)的電流放大率小於 β
- 關於 P-N 接面二極體崩潰電壓之敘述,下列何者錯誤?
 - (A)逆向崩潰電壓較順向導通電壓為大
 - (B)PN 區域雜質濃度越高,若發生稽納式崩潰(Zener breakdown)時,崩潰電壓越大
 - (C)溫度越高,若發生雪崩式崩潰(Avalanche breakdown)時,崩潰電壓越大
 - (D)雪崩式崩潰(Avalanche breakdown)之崩潰電壓較稽納式崩潰(Zener breakdown)之崩潰電壓為大
- 如圖所示之電路為何種濾波器?



(A)低通

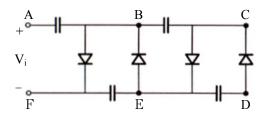
(B)帶通

(C)高通

(D)全通

代號:3909 頁次:7-2

- 8 將砷(As)元素經熱擴散摻進純矽晶體中且取代矽原子,此矽晶體將成為何種摻雜型式半導體? (A)正(P)型 (B)負(N)型 (C)以上皆有可能 (D)無法確定
- 圖中理想二極體電路輸入正弦波訊號的峯值為 V_m ,請問在那兩個端點間可得到 $4V_m$ 的輸出?



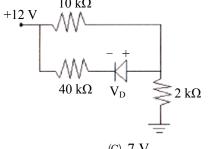
(A)A、B 端點

(B)A、C 端點

(C)F、E 端點

(D)F、D 端點

如圖所示,跨於二極體的電壓 V_D應為: 10



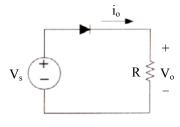
(A)0.7 V

(B)-5V

(C)-7 V

(D)-10 V

11 如圖所示之電路,二極體為理想。其電源電壓 v_s 為一交流弦波,大小為 110 Vrms,頻率為 60 Hz, R=25 Ω , 則 i_o之均方根值 (rms) 為何?



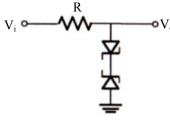
(A)2.11 A

(B)3.11 A

(C)4.11 A

(D)5.11 A

12 圖中為一由兩個 5.7 V 稽納 (Zener) 二極體所構成的截波電路,其順偏時的電壓為 0.7 V,請問輸入 波形被截波的電壓為何?



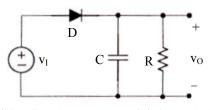
 $(A)\pm 1.4 V$

 $(B)\pm 5$ V

 $(C)\pm6.4 \text{ V}$

 $(D)\pm11.4 \text{ V}$

圖示整流電路,輸入 v_I 為弦波,若二極體D的導通角度變大,下列敘述何者為其可能原因? 13



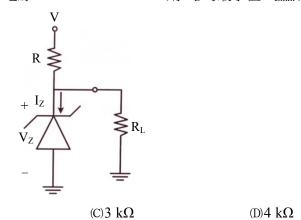
(A)v_I的週期變大

(B)v_I的峰值電壓變大

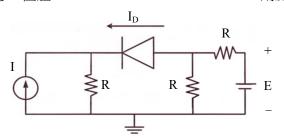
(C)電容值 C 變大

(D)電阻值 R 變大

14 如圖電路,稽納二極體的 V_z =5 V,電源 V=10 V,R=2 $k\Omega$,則 R_L 的最小值 R_{Lmin} 約為多大?



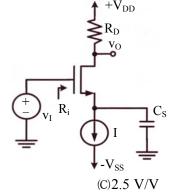
15 如圖電路,設二極體為理想二極體。 $I=1\ mA$, $E=10\ V$, $R=10\ k\Omega$,則流經二極體之電流 I_D 為多大?



(A) 0 mA (B) 0.5 mA (C) 1 mA (D) 2 mA

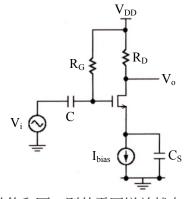
(B)2 $k\Omega$

16 如圖電路為一共源放大器的簡圖,若電晶體之 g_m =0.5 mA/V, V_A = ∞ , R_D =5 k Ω ,則此放大器的電壓增益 |Av|為:



 ∞ (D)

17 關於下列之放大器,若電晶體操作於飽和區,且電流源為理想,下列敘述何者錯誤?



(A)I_{bias}增加,若電晶體維持操作於飽和區,則其電壓增益越大

(B)2 V/V

(B)Cs=0 則其電壓增益為 0

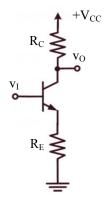
(A) $1 k\Omega$

(A)0

- (C)若 W/L 減少則電晶體可能從飽和區進入三極管區(triode region)
- (D)若 R_D增加則電晶體可能從飽和區進入三極管區 (triode region)

代號:3909

18 如圖的放大器(其偏壓電路未示),若電晶體的轉導參數為 g_m ,輸出電阻為 r_o ,則此放大器的電壓 增益約為何?



(A)- g_mR_C

(B)- $g_m(R_C//r_o)$

 $(C)-R_C/R_E$

 $(D)-r_o/R_E$

19 雙極性接面電晶體中,下列何種電路組態其小訊號輸入阻抗為最大?

(A) 共射極組態

(B)共基極組態

(C)共集極組態

(D)共閘極組態

20 若要使一操作於飽和區的 MOS 電晶體的轉導值增為 2 倍,可藉由下列的何種方式改變汲極電流 ID 來達成?

(A)將 I_D增為 4 倍

(B)將 I_D增為2倍

(C)將 I_D 增為 $\sqrt{2}$ 倍

(D)將 I_D減半

21 有關 BJT 雙極性接面電晶體與 FET 場效電晶體的一般特性比較,下列何者錯誤?

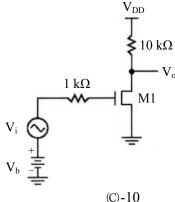
(A)BJT 的轉導(Transconductance)gm比 FET 的轉導大

(B)BJT 的輸出電阻 r。比 FET 的輸出電阻小

(C)BJT 的本質增益(Intrinsic Gain) A₀比 FET 的本質增益大

(D)BJT 的輸入阻抗 R_i比 FET 的輸入阻抗小

22 如圖所示之電路,若MOSFET操作在飽和區(Saturation Region)且轉導值(gm)為1 mA/V,輸出 阻抗 (r_o) 為 $10 \, k\Omega$,試求 V_o/V_i =?

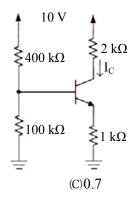


(A)-2.5

(B)-5

(D)-20

23 圖示電路,若電晶體 β=100, $V_{BE(on)}=0.7$ V,電流 I_C 約為若干 mA?



(A) 0.2

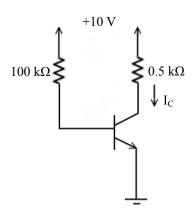
(B)0.4

(D)1.3

24 P 通道空乏型 MOSFET 閘極加上正電壓時,其通道導通程度會:

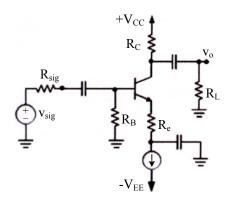
(A)減小 (B)加大 (C)無影響 (D)不一定

25 如圖電路,設電晶體的 β =100, V_{BE} =0.7 V,則 I_{C} 電流約為:



(A) 19.6 mA (B) 9.3 mA (C) 0.1 mA

26 圖示放大器電路中的電阻 Re主要功用為何?



(A)降低輸出阻抗 (B)提升電壓增益

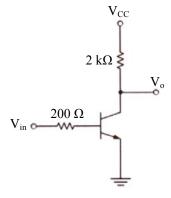
(C)提高輸入訊號的線性放大範圍 (D)頻率補償

27 在 BJT 的小訊號參數中,下列那一個關係式錯誤?

 $(A)r_e = V_T/I_E$ $(B)r_\pi = V_T/I_B$ $(C)g_m = I_C/V_T$ $(D)r_o = V_T/I_C$

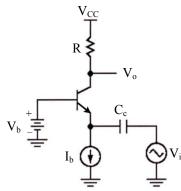
28 如圖所示之電路,假設 BJT 電晶體操作在順向主動區,忽略爾利 (Early)效應, I_C =1 mA, V_T =26 mV, β=100, C_π =100 fF, C_μ =20 fF,且 C_{CS} =30 fF,採用米勒(Miller)趨近法,求於 BJT 輸入端之極點

頻率為何?



(A) 516 MHz (B) 616 MHz (C) 716 MHz (D) 816 MHz

29 如圖所示之電路,若忽略元件本身之寄生電容,下列敘述何者錯誤?



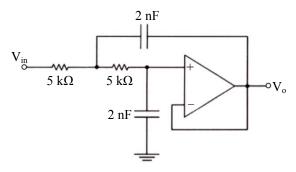
(A)該電路為高通放大器

(B)增加 I_b 有助於降低低頻-3 dB 頻率(ω_L)

 $(C)C_c$ 增加有助於降低低頻-3 dB 頻率 (ω_L)

D該電路為同相放大器

, 求ω_n 為何? 30



(A) 10 kHz

(B)50 kHz

 $(C)100 \ kHz$

(D)200 kHz

非反向運算放大器電路具有增益 40 dB, 其 3 dB 頻率為 25 kHz, 將其應用在某特殊系統中, 若此系 31 統需要 50 kHz 的頻寬,在此情況下能夠達到的最大增益為何?

(A)10 V/V

(B)20 V/V

(C)50 V/V

(D) 100 V/V

關於 CC-CC 放大器的特性,下列何者正確? 32

(A)低輸入阻抗

(B)高輸出阻抗

(C)高電壓增益

(D)高電流增益

若增加差動放大器中之射極電阻,則: 33

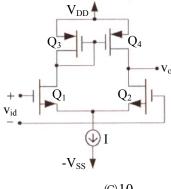
(A)A_{cm}增加

(B)A_{cm}不變

(C)CMRR 值增加

(D)CMRR 值減少

34 圖示差動放大器,若電晶體 Q_1 與 Q_2 的特性相同, Q_3 與 Q_4 的特性相同, 且其轉導 (Transconductance) g_m 皆為 2 mA/V、輸出電阻 r_o 皆為 20 k Ω ,則差模電壓增益 $A_d=v_o/v_{id}=?$



(A)-20

(B)-10

(C)10

(D)20

於此電路的轉角頻率(Corner Frequency)時,頻率與

|T(s)|的變化關係,下列何者正確?

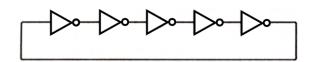
(A)頻率每增大十倍, |T(s)|減少 10 dB

(B)頻率每增大十倍, |T(s)|減少 20 dB

(C)頻率每增大二倍, |T(s)|減少10 dB

(D)頻率每增大二倍, |T(s)|減少20 dB

36 下圖由 5 個 NOT 閘組成之環形振盪器,若每一個 NOT 閘的延遲時間(Delay Time)為 2 ns,則此電路之振盪頻率為多少?



(A)25 MHz

 $(B)50\ MHz$

(C) 100 MHz

(D) 125 MHz

一個兩級串接放大器電路,其第一級放大器之低 3 分貝頻率(Lower 3 dB Frequency)與高 3 分貝頻率(Upper 3 dB Frequency)分別為 1 kHz 與 1 MHz。電路中第二級放大器之低 3 分貝頻率(Lower 3 dB Frequency)與高 3 分貝頻率(Upper 3 dB Frequency)分別為 10 kHz 與 2 MHz。則此放大器之頻 寬約為:

(A)990 kHz

(B)999 kHz

(C) 1990 kHz

(D) 1999 kHz

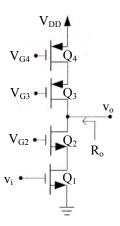
38 關於韋恩(Wien)振盪器,下列敘述何者正確?

(A)振盪波形為方波

(B)振盪波形為三角波

(C)振盪波形為單一脈波 (D)振盪波形為弦波

39 圖示放大器中所有電晶體特性完全相同且匹配,所有電晶體的 $|V_A|=2\ V$,過驅電壓(Overdrive voltage) $|V_{OV}|=|V_{GS}-V_t|=0.2\ V$,工作電流 I_D 皆為 $0.2\ mA$,則輸出阻抗 R_o 約為若干 $k\Omega$?



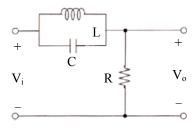
(A)50

(B)100

 $(C)\,150$

(D)200

40 下列為一被動式濾波器(Passive filter),試研判此電路是何種濾波器?



(A)低通濾波器

(B)高通濾波器

(C)帶通濾波器

(D)帶拒濾波器